

增刊

HgCdTe中特征正电子湮没寿命值的确定

何元金¹, 辛明瑞², 张天保³

1 清华大学现代应用物理系 北京 100084)

(2 中国陕西骊山微电子公司 西安 710600)

(3 中国科学院高能物理研究所应用部 北京 100080)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 提出了一种新的在热平衡状态下实时测量碲镉汞(MCT)中特征正电子湮没寿命的方法,用该方法测得HgCdTe中基体正电子湮没寿命 τ_b 为 277 ± 1 Ps,汞空位缺陷捕获态寿命 τ_d 为 306 ± 2 ps,并与用其它方法测量的结果进行了比较与讨论.

关键词 [正电子湮没](#) [碲镉汞半导体缺陷](#) [汞空位](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

何元金

作者个人主页: [何元金¹](#); [辛明瑞²](#); [张天保³](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDE\(138KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“正电子湮没”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [何元金](#)

· [辛明瑞](#)

· [张天保](#)